

FLANGED QUARTZ CRUCIBLE

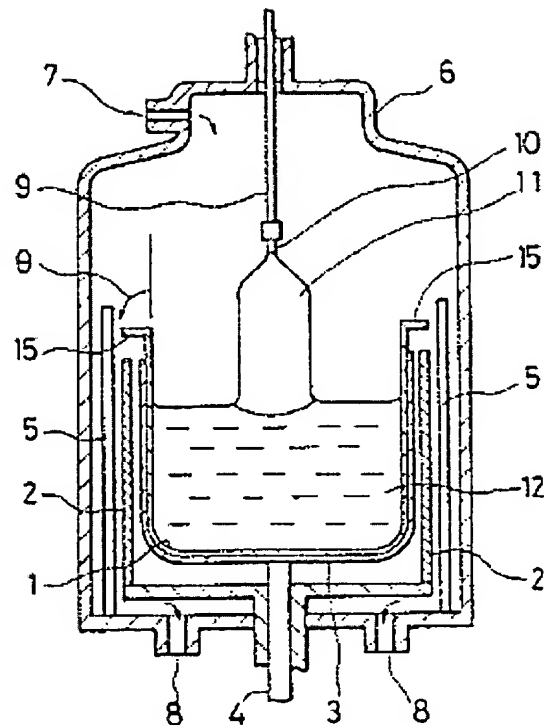
Patent number: JP63319288
Publication date: 1988-12-27
Inventor: YAMAGISHI HIROTOSHI
Applicant: SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD
Classification:
- international: C30B15/10
- european:
Application number: JP19870156263 19870623
Priority number(s):

[Report a data error](#)

Abstract of JP63319288

PURPOSE:To control the carbon content in a pulled-up single crystal Si to an extremely small value and to obtain the title crucible for pulling up a high- quality semiconductor single crystal Si rod by providing a flange inclined beyond a specified angle range from the vertical direction and having a specified width on the upper edge of a quartz crucible.

CONSTITUTION:In the quartz crucible 1 to be used at the time of pulling up a semiconductor single crystal Si rod 11 by the Czochralski method, a flange 15 inclined outward at an angle of 30-120 deg. to the vertical direction and having 5-50mm width is provided on the upper edge of a cylindrical side wall. As a result, a graphite susceptor 3 and a graphite heater 2 are covered by the flange 15, and hence the CO or CO₂ generated therefrom hardly reach the crucible 1. Consequently, the carbon content in the single crystal Si rod pulled up with the use of the flanged quartz crucible can be controlled to ≤ 0.01 ppm.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Patent Abstracts of Japan

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-319288

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)12月27日

C 30 B 15/10

8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 鋳付石英るつぼ

⑯ 特 願 昭62-156263

⑰ 出 願 昭62(1987)6月23日

⑱ 発 明 者 山 岸 浩 利

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越半導体株式会社半
導体研究所内

⑲ 出 願 人 信越半導体株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 山本 亮一

外1名

明 細 書

1. 発明の名称

鋳付石英るつぼ

2. 特許請求の範囲

チョコラルスキー法で半導体単結晶シリコン棒を引上げる際使用する石英るつぼにおいて、鉛直上方向より30°乃至120°外に向かって傾き、幅が5～50mmである鋳を円筒状側壁上縁に設けたことを特徴とする鋳付石英るつぼ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、チョコラルスキー法によって引上げる半導体単結晶シリコン棒の品質向上特に炭素含有量を低減する石英るつぼの構造に関する。

(従来の技術とその問題点)

半導体シリコン単結晶棒は、ウエーハに加工されて、半導体素子あるいは半導体集積回路素子製造のためのシリコン基板に用いられるが、いかに高純度の多結晶を用いても、基板の炭素含有量が多くなり1ppmにも達することがある。かかる基

板は前記用途に適さない。たとえば含有量が0.5ppm程度のウエーハで半導体素子あるいは半導体集積回路素子を製造すると、PN接合における耐圧が低下し、またMOS構造デバイスにおいては電極間にリーク電流を発生することもある。炭素含有量は最低限に抑えなければならないので種々の手段が講じられているが、以下に述べるように、いずれも十分な効果をあげるにいたっていない。

第2図に示す装置は、従来のチョコラルスキー法による単結晶シリコン棒製造装置であるが、石英るつぼ1に原料として多結晶シリコンをチャージし、ヒーター2によって加熱溶融する。るつぼ1はグラファイトサセプター3に嵌合し、底中央を回転軸4によって支持され、ヒートシールド5とともにチャンバー6内に収容されている。雰囲気ガスは供給口7より導入され、排出口8より排出される。ヒーターにより加熱して多結晶シリコンを充分溶融した後、引上げ軸9の下端に挟持した種結晶10を融液に浸漬し引上げると単結晶11が育成される。

しかしながらこの方法では、チャンバー内のグラファイト材より徐々に放出される酸素または水分がヒーターと反応し酸化炭素ガスを、また石英るつぼとサセプターとの接触により一酸化炭素ガスを生じ、これらが逆流してシリコン融液12を汚染する。

これを避けるため、石英るつぼ1の上縁13をサセプター上縁14より高くすれば、るつぼ上縁がヒーターより遠ざかって温度が低下し、ここに析出した一酸化珪素がシリコン融液12中に落下して単結晶の育成が乱される。またチャンバー内のグラファイト材を酸化珪素で被覆する方法も提案されたが、汚染防止には効果があるものの高価に過ぎ経済的でないという問題点があった。さらにヒートシールド5の上縁にドーナツ状円板の遮蔽具を設ける方法も検討されたが、シリコン融液への炭素の混入を効果的に防止することはできなかった。(問題点を解決するための手段)

本発明者は、前記問題点を解決するための種々検討を重ねた結果、石英るつぼの上縁形状を若干変

更することにより、単結晶化率を低下させることなく、炭素含有量の少ない単結晶シリコンを製造することに成功したのであって、これはチョクラルスキー法で半導体単結晶シリコン棒を引上げる際使用する石英るつぼにおいて、鉛直上方向より30°乃至120°外に向かって傾き、幅が5~50mmである鉤を円筒状側壁上縁に設けたことを特徴とする鉤付石英るつぼである。

本発明の鉤付石英るつぼを使用したチョクラルスキー法による単結晶シリコン棒の引上げ装置の一実施態様を第1図に示す。

鉤15は、少なくともグラファイトサセプターの上縁をカバーすればよいので、5mm幅あれば充分であるが、さらに好ましくはグラファイトヒーターをも覆うようにすれば完全である。シリコン単結晶の汚染を避ける本発明の目的を助長するためには、鉤15はさらにその幅が拡張されることが好ましいが、ヒーター2を囲むヒートシールド5を超えて拡張することはできないのでおのずから限界がある。このような理由から上限として約50mm

- 3 -

が選ばれる。また鉤の上方に向かう鉛直線に対する傾き角θは30°以上120°まで増大することはできる。また本発明の石英るつぼは一酸化珪素のシリコン融液面への落下防止に効果がある。

(作用)

第1図より明らかなように、石英るつぼ上縁に外に向かって設けた鉤15がグラファイトサセプターおよびグラファイトヒーターを覆っているため、これらから発生する一酸化炭素または二酸化炭素は石英るつぼに到達することは容易でない。これは、前記酸化炭素が石英るつぼの中のシリコン融液12に接触するためには、石英鉤表面と雰囲気ガスの境界層流域を拡散で逆流しなければならないためである。

(実施例)

第1図に示すチョクラルスキー法による単結晶シリコン棒引上げ装置において、本発明の石英るつぼ(直径45cm、高さ40cmのるつぼに幅50mm、θ=90°の鉤をとりつけたもの)にシリコン多結晶塊50kgをチャージして熔融し、アンドープでアル

- 4 -

ゴンガスを内圧50mmに保ちながら、50g/分の流量で流入させ、引上げ方位(100°)で直径160mmの単結晶シリコン棒を5パッチ引上げた。これら単結晶棒の尾部側の固化率85%の位置からウエーハを切出し、赤外線吸収式カーボン濃度測定器で測定したところ、置換型カーボンは検出されなかった(この装置のカーボン検出可能量は0.01ppma以上である)。

(比較例)

鉤をつけない従来の石英るつぼを使った以外は実施例と同じ条件で単結晶を引上げたところ、平均0.15ppmaの置換型カーボンが検出された。

(発明の効果)

上記したように、本発明の石英るつぼは引上げ単結晶シリコンの炭素含有量を0.01ppma以下に抑えることができ、しかも経済的で産業上有為な発明である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の鉤付石英るつぼを使用したチョクラルスキー法による単結晶シリコン棒引上げ装

- 5 -

—506—

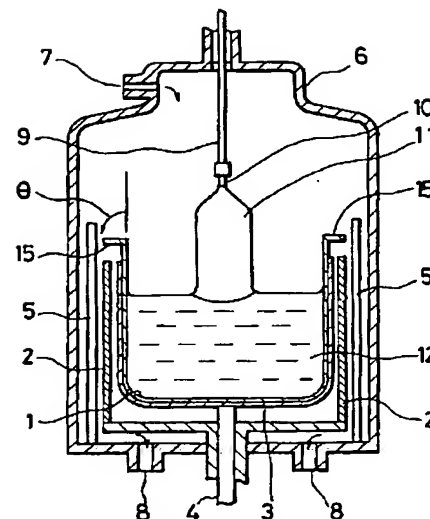
- 6 -

BEST AVAILABLE COPY

図の縦断面図を、第2図は従来の石英るつぼを使用したチョクラルスキー法による単結晶シリコン棒引上装置の縦断面図を示す。

- | | |
|------------|----------------|
| 1…石英るつぼ、 | 2…ヒーター、 |
| 3…サセプター、 | 4…回転軸、 |
| 5…ヒートシールド、 | 6…チャンバー、 |
| 7…供給口、 | 8…排出口、 |
| 9…引上げ軸、 | 10…種結晶、 |
| 11…単結晶、 | 12…融液、 |
| 13…るつぼ上縁、 | 14…サセプター上縁、 |
| 15…錐、 | θ …傾き角。 |

第1図



特許出願人

信越半導体株式会社

代理人・井理士

山本 亮

"

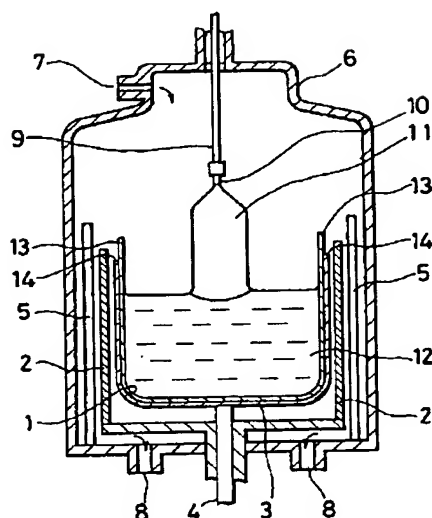
"

荒井 雄



- 7 -

第2図



特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 62 年特許願第 156263 号 (特開昭
63-319288 号, 昭和 63 年 12 月 27 日
発行 公開特許公報 63-3193 号掲載) につ
いては特許法第17条の2の規定による補正があっ
たので下記のとおり掲載する。 3 (1)

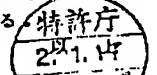
Int. Cl. ' 識別記号	庁内整理番号
C30B 15/10	8518-4G

平成 2.4.24 発
手 続 補 正 書 (自発)

平成 2年 1月16日

特許庁長官 吉 出 文 毅 殿

1. 事件の表示
昭和62年特許願第156263号
2. 発明の名称
銅付石英るつぼ
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
名称 信越半導体株式会社
4. 代理人
住所 〒103東京都中央区日本橋本町4丁目4番11号
永井ビル [電話 東京 (270) 0858]
氏名 弁護士 (6282) 山 本 亮 一
住所 同 所
氏名 弁護士 (9373) 荒 井 雄 司
5. 補正の対象
明細書
6. 補正の内容
1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおりに補正する。
2) 明細書第4頁第3～4行の「チョコラルスキー」を、「チョコラルスキー」と補正する。



特許請求の範囲

チョコラルスキー法で半導体単結晶シリコン棒を引上げる際使用する石英るつぼにおいて、鉛直上方向より30°乃至120°外に向かって傾き、幅が5～50mmである銅を円筒状側壁上縁に設けたことを特徴とする銅付石英るつぼ。

(63) - 1 -

BEST AVAILABLE COPY